А. В. Баранов, Н.Н. Баранова Н. Н, О.В. Буркина

СРАВНЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ В СОЛНЕЧНЫХ ПЯТНАХ РАЗЛИЧНОЙ ПЛОЩАДИ

Несколько десятилетий назад зависимость напряженности магнитного поля Н от площади солнечного пятна S считалась очевидной и достаточно интенсивно изучалась. По данным рутинных наблюдений [4,6] зависимость имеет значительный, > 0,8, коэффициент корреляции. Сравнение патрульных наблюдений Н, полученных при удовлетворительном и хорошем качестве изображения [4], показывает, что занижение Н в пятнах площадью меньше 10 миллионных долей полусферы (м. д. п.) составляет в первом случае почти 300 Э (обозначения здесь общепринятые). Имеется факт значительного уменьшения наблюдаемой Н в малых пятнах, связанный с искажениями профилей линий паразитным светом. При подобных измерениях представляется важным присутствие наблюдательной селекции – магнитное поле измеряется в тех малых пятнах, где заметно расщепление линии. По этой причине малые пятна с малой напряженностью поля, если они есть, в статистику наблюдений не попадут. Понятно, что при анализе визуальных измерений магнитного поля в любом случае остается неопределенность, связанная с отмеченными эффектами. Важным является то, что имеются образования малого масштаба, в которых есть значительные, около 2000 Э магнитные поля, что получено как из анализа профилей спектральных линий [2,8,9], так и визуальными измерениями [3,4,7,10]. Однако проблема существования малых образовании с относительно небольшим магнитным полем, как нам кажется, не решена. Здесь мы сталкиваемся с двумя вопросами: насколько тесна связь H и S и есть ли пятна одинаковой площади, имеющие различную максимальную напряженность магнитного поля?

Частью авторов данной работы была сделана попытка изучить зависимость H и S, анализируя с помощью теории Унно профили Стокса линии Fe I λ 6302.5 Å [3] и шести линий трех разных эле-

ментов [4]. При расчете профилей интенсивности и круговой поляризации в [3] использовалась температурная модель пятна Кнеера [11]. Доплеровская полуширина линии при этом полагалась постоянной по глубине и равной 25 mÅ, а значение постоянной затухания a = 0,19 полагалось равным ее величине на уровне эффективного образования линии, что, несомненно, вносило неточности в определение поля. Тем не менее при анализе г_v-профилей в значительной степени устранялось влияние рассеянного света. Зависимость Н и S при этом проявлялась очень четко.

К настоящему времени у нас собран большой наблюдательный материал, современная техника позволяет проводить массовую фотометрическую обработку спектральных линий и подбирать для каждого конкретного профиля наиболее подходящий теоретический профиль, рассчитанный для реальной модели пятна без использования каких-либо упрощающих предположений [3,4]. Поэтому нами была поставлена задача: с учетом возможных ошибок, используя теорию образования спектральных линий в магнитном поле, проанализировать по наблюдаемым профилям линии Fe I λ 6302.5 Å связь величин H и S и меру ее неоднозначности.

Спектры были получены на горизонтальном солнечном телескопе АЦУ-5 в четвертом порядке спектрографа АСП-20 при дисперсии 2,57 Å/мм. Ширина инструментального профиля 26 mÅ. Спектральное окно захватывало диапазон длин волн $\lambda\lambda$ 6210–6340ÅÅ. Полученный материал в перспективе позволяет изучать напряженность магнитного поля примерно по 30 спектральным линиям разных элементов и ставить соответствующие задачи. Фокусировка была выполнена на длине волны $\lambda \sim 6270$ Å. В течение всего августа 1989 г. было очень высокое качество изображения, дрожания на лучших снимках не превышали 1–2", практически полностью отсутствовал ореол, поэтому за основу исследования был взят именно этот временной интервал, который дополняли спектрограммы высокого качества, полученные в другое время. Дополнительным критерием отбора была отчетливая видимость в спектре пятна молекулярных линий. В данной работе проанализированы отдельные аспекты связи напряженности магнитного поля Н и площади S для 78 солнечных пятен. На примере главных пятен группы N 289 СД от 1.08.1989 г. (S = 824 м. д. п., r/R = 0,57, пятно 1) и группы N 301 СД от 9.08.1989 г. (S =121 м. д. п. r/R = 0,46, пятно 2) рассмотрим основные особенности величины Н в пятнах различной площади.

При сравнении анализировались профили линии Fe I λ 6302.5Å в спектрах право- и левокруговой поляризаций (r₊ и r₋). Характерные примеры этих профилей для двух пятен приведены на рис.1,а и 2,а соответственно. Рассчитаны профили интенсивности r_I = r₊+r. (рис.1,б и 2,б) и круговой поляризации r_V = r₊ - r₋ (рис.1,в и 2,в), по которым определены H.

В пятне 2 г_v-профиль (рис.2,в) показывает обращение знака у центра линии, что характерно для магнитного поля значительной величины. Для пятна малой площади это отмечено впервые и говорит о том, что величина паразитного света в его спектре мала. Величина H_{σ} , найденная по положению σ -компонентов г₊- и г.-профилей, составляет 2070 Э. По теории образования линий в магнитном поле $H_{\sigma} \leq H$. Величина H_{v} , определенная по положению максимумов г_v-профилей, составляет 2260 Э и согласно теории $H_{v} \geq H$. Истинное значение $H_{\sigma} \leq H \leq H_{v}$.

В пятне 1 величина $H_{\sigma} = 2750$ Э, величина $H_V = 2820$ Э и $H_{\sigma} \le H_V$. Если принять, что контраст пятна по отношению к фотосфере составляет 0,10–0,15, то поправка при учете действия на профили Стокса линии рассеянного из фотосферы света получается такой величины, что полностью убирает из профиля интенсивности линии π -компонент расщепления (отметим, что для крупных пятен эта ситуация является типичной). В то же время мы видим на профиле круговой поляризации линии инверсию r_V -профиля, присущую при величине H>2000 Э углу наклона силовых линий к лучу зрения $\gamma > >30^\circ$. При таких γ глубина π -компонента линии на теоретически рассчитанных профилях составляет около 0,5 глубины δ -компонента и почти одинакова для любой использованной в расчетах модели пятна. Это в значительной мере ограничивает величину коррекции профиля линии при учете рассеянного света, и указан-



Рис.1. Фотометрические профили и профили интенсивности и круговой поляризации для большого пятна. По горизонтальной оси отсчеты даны в миллиметрах. По вертикальной оси – не калиброванные на интенсивность непрерывного спектра значения величин



Рис.2. Фотометрические профили, а также профили интенсивности и круговой поляризации для малого пятна. По горизонтальной оси отсчеты даны в миллиметрах. По вертикальной оси – не калиброванные на интенсивность непрерывного спектра значения величин

ные выше величины Н являются истинными верхней и нижней границами возможного значения напряженности поля.

По результатам анализа полученных нами профилей максимально возможное значение Н поля в малом пятне на 490 Э меньше минимально возможного значения Н в большом пятне. Различие подобной величины показано и на приведенном в статье рис.2. Во всех данных случаях напряженность поля в большом пятне больше, причем различия Н, определенные с помощью теории, находятся в пределах от 480 до 650 Э. При этом среднее различие Н составляет 600 Э.

Никакими разумными предположениями о величине замывания изображения и форме профилей, искажающих г₁- и г_v-профили линии, такое различие получить нельзя. Данные не укладываются в общепринятую картину практического отсутствия зависимости H от S, поэтому закономерен вопрос об исследовании связи этих величин.

Результаты анализа связи Н и S по профилям линии в 78 пятнах таковы.

Разность величин $\delta H = H_V - H_\sigma\,$ с ростом H_V уменьшается от значений 300–400 Э при $H_V \! < \! 1800$ Э до значений 20–60 Э при $H_V \! \sim \! 3000$ Э. Подобное изменение может быть как согласно теории, так и в результате искажения профилей линии рассеянным светом. Важным представляется то, что в больших пятнах величины H_V и H_σ практически совпадают.

Отчетливо проявляется связь величин H_{σ} и S. Ни одно из измеренных пятен с S < 90 м. д. п. не имеет значений H_{σ} больше 2320 Э и меньше 1400 Э. В то же время все пятна с S > 90 м. д. п. имеют напряженность поля в диапазоне H_{σ} от 2000 до 3240 Э.

Для сравнения все изученные пятна были поделены на группы, соответствующие интервалам, приведенным в головке таблицы. В каждом из интервалов были посчитаны средние значения H_{σ} и среднеквадратическое отклонение от среднего δH_{σ} (строка 1, значения H_{σ} приведены в сотнях эрстед). Оно в данном случае характеризует не ошибку измерения, которая значительно меньше (напомним, что

истинное значение поля находится в пределах $H_{\sigma} \le H \le H_V$), а разброс значений H_{σ} для пятен данного интервала. Нами также выполнено сопоставление H_V и S. Значения H_V и ее дисперсии δH_V приведены в строке 2 таблицы. Несложно видеть, что разность значений в 1 и 2-й строках таблицы соответствует среднему по интервалу значению $\delta H = H_V - H_{\sigma}$, (диапазону, в котором находится истинное значение H). Анализ данных позволяет утверждать, что зависимость H_V от S выражена несколько более четко чем связь H_{σ} и S. Это видно и из данных таблицы, для всех интервалов которой отмечается неравенство $\delta H_V \le \delta H_{\sigma}$.

S, м.д.п.	<16	16–40	40-100	100-250	>250
$H_{\sigma} \pm \delta H_{\sigma}(\Theta)$	16,0±2,5	18,3±1,6	19,1±1,8	24,0±3,1	25,9±3,4
$H_V \pm \delta H_V(\Im)$	18,7±2,1	20,3±1,5	21,3±1,6	25,3±2,9	27,1±3,3

Однако как для H_{σ} , так и для H_V в пятнах с S > 16 м. д. п. отмечена общая особенность – увеличение разброса их значений с ростом величины магнитного поля. Так, для величины H_v 74 из 78 ее значений лежат внутри области, ограниченной на графике линиями $H_V(\Im) = 1312 + 815 lgS$ (м. д. п.) сверху и $H_V(\Im) = 1250 + +410 lgS$ (м. д. п.) снизу. При этом само уравнение связи величин имеет вид $H_{v}(\Im) = 1305 + 533 \text{ lgS}$ (м. д. п.). Примечательно, что все три прямые пересекаются практически в одной точке при значениях H_V ~1200 Э и S ~ 0,4-0,9 м. д. п. Подобная операция для величины Н_о показывает качественно тот же результат, но из-за большего разброса ее значений в области S < 100 м. д. п. "граничные" линии на графике проводятся менее уверенно. Тем не менее 73 из 78 значений Н_о лежат внутри области, ограниченной на графике линиями $H_{\sigma}(\Im) = 1100 + 900 \text{ lgS}$ (м. д. п.) сверху и $H_{\sigma}(\Im) = 1020 + 400 \text{ lgS}$ (м. д. п.) снизу. Уравнение связи величин имеет вид $H_{\sigma}(\Im) = 1000 +$ + 600 lgS (м. д. п.). Пересечение линий происходит при $H_{\sigma} \sim$ ~800-1000 Э и S ~ 0,5 - 1,2 м. д. п.

Таким образом, более четко выраженная картина связи наблюдается при сравнении H_V и S. Большой разброс значений H_σ объясняется тем, что профили линий в пятнах, особенно малых, сильно искажены рассеянным из фотосферы светом. При этом профили фотосферных линий практически не поляризованы и, сильно искажая профили интенсивности $r_I = r_++r_.$ (см. рис.1,б и 2,б), существенно не изменяют профили круговой поляризации $r_V = r_+ - r_.$ (см. рис.1, в и 2,в). Соответственно, величина $r_{I_1}+r_V$, по которой определяется величина H_{σ} , сильно искажена, причем в разной степени при разных условиях наблюдений. Тем не менее в больших пятнах нами получено практическое равенство величин H_{σ} и H_V (различие находится в пределах 100 Э). При этом различия величин H_{σ} и H_V в разных крупных пятнах большой площади достигает 940–1030 Э. Это позволяет считать, что связь Н и S неоднозначна. Приведеные здесь результаты позволяют предполагать, что существует некоторые пороговые значения напряженности поля, ниже которых у соответствующей площади пятен значений не бывает и указанный "порог" в первом приближении можно описать выражением

H_V(Э) = 1250 + 410 lgS (м. д. п.).

Данные таблицы показывают, что разброс напряженности поля с ростом площади пятен возрастает, т. е. напряженность магнитного поля в малых пятнах в абсолютных значениях меняется меньше, чем в больших.

Результаты являются предварительными, но, на наш взгляд, определяют направление и показывают необходимость исследований указанных особенностей связи Н и S.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Брей Р., Лоухед Р.* Солнечные пятна. М.: Мир, 1967. 275 с.

2. *Баранов А. В.* Магнитные поля малых солнечных пятен // Астроном. циркуляр. 1974. № 847. С. 3-5.

3. Баранов А. В. Аппроксимация усредненных характеристик магнитного поля солнечного пятна на основе потенциальной модели // Исследование магнитных полей и активных образований на Солнце. Владивосток, 1984. С. 33-48.

4. Баранов А. В. Баранова Н. Н. Связь напряженности магнитного поля и площади солнечных пятен // Методы и результаты исследования Солнца. Владивосток, 1986. С. 66-75.

5. Баранов А. В. Зависимость магнитного поля солнечного пятна от площади по различным линиям поглощения: Препр. Владивосток, 1987. 14 с.

6. Ихсанов Р. Н. О связи между напряженностью магнитного поля и площадью солнечных пятен // Изв. ГАО. 1966. №180. С.41-50.

7. Стешенко Н. В. Магнитные поля малых солнечных пятен и пор // Изв. КрАО. 1967. № 37. С.21-28.

8. Beckers J. M., Schroter E. N. The Intensity, Velosity and Magnetic Structure of a Sunspot Region. I. Observational tecnique; Properties of magnetic knots // Solar Phys. 1968. V. 4, N_{2} 2. P. 142-164.

9. Brants J. J., Zwaan G. The Structure of Sunspots. IV. Magnetic Field Strengths in Small Sunspots and Pores // Solar Phys. 1982. V. 80, № 2. P. 251-258.

10. Bumba V. Magnetic Fields in Small and Young Sunspots // Solar Phys. 1967. V. 1, $N \ge 2$. P. 371-376.

11. Kneer F. Line Profiles in Sunspots // Astron. and Astrophys. 1972. V.18, N 2. P. 47-50.

А.В. Баранов, Г.И. Корниенко

АНАЛИЗ СВОЙСТВ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ВБЛИЗИ АКТИВНОГО ВОЛОКНА

Известно, что приближение потенциального магнитного поля удовлетворительно описывает поле активных областей. Однако существует класс структур, где оно не выполняется, что указывает на наличие в солнечной атмосфере электрических токов. К таковым относятся прежде всего суперполутени солнечных пятен, чья тонкая структура показывает спиральную закрученность, и жгутообразные волокна, состоящие из тонких скрученных нитей.

Расчеты, выполненные с использованием карт полного вектора магнитного поля, позволили сделать вывод о существовании в активных областях Солнца как глобальных, так и локальных мелкомасштабных электрических токов с плотностью до 10^{-4} A/m² и полным током до 10^{12} A (см., напр., [6]). Подобные токи играют важную роль в энергетике активных областей и протекающих в них нестационарных процессов.

Скрученные жгуты волокон наблюдаются достаточно часто. Их можно видеть на H_{α} -фильтрограммах как в проекции на диск Солнца, так и за лимбом. Появление жгутообразных волокон может быть определенной стадией развития активного волокна. Есть данные о том, что в процессе солнечной вспышки скрученность связанного с ней волокна уменьшается [7,11]. По наблюдениям над солнечным лимбом было обнаружено, что радиусы жгутов достигают 10^4 км, а поперечники составляющих их волокон около 10^3 км [12]. Скрученное волокно в течение длительного времени может оставаться устойчивым, а потом стать эруптивным, либо вблизи него происходит вспышка.

Скрученность жгутов волокон явно указывает на текущие в них электрические токи. Если магнитное поле жгута разложить на две компоненты (B_1 – поле вдоль оси жгута (аксиальное поле) и B_{ϕ} –